

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаборатории Неравновесных процессов в полупроводниках
Вакансия VAC_36887

Тематика исследований

Исследования и разработки в области методов выращивания объемных кристаллов нитрида галлия.

Трудовая деятельность

Участие в научных исследованиях по разработке методов получения совершенных объемных кристаллов и эпитаксиальных слоев нитрида галлия.

Особенности трудовой деятельности:

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Неравновесных процессов в полупроводниках на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени кандидата физико-математических наук.
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus (шт.): не менее 10, Web of Science (шт.): не менее 10.
- Индекс Хирша по Web of Science: не менее 5.
- Опыт научной работы: не менее 5 лет.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).